


	<h2 style="color: red;">SI4511DY-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4511DY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 7.2A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4511DY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2588 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4511DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 7.2A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2588 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.5 mOhm @ 9.6A, 10V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4511DY-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 20V 7.2A, 4.6A 1.1W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.2A, 4.6A
Basisteilenummer	SI4511

SI4511DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4511DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4511DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4511DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4532A VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI4511DY VISHAY SI4511DY VISHAY</p>	 <p>SI4532ADY VISHAY SI4532ADY VISHAY</p>	 <p>SI4532 SI SI SOP8</p>
 <p>SI4511DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 7.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI4511 SI SI4511 SI</p>	 <p>SI4511DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 7.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI4532ADY-T1 SILICON SI4532ADY-T1 SILICON</p>

SI4511DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4511DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4511DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4511DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4511DY-T1-GE3
SI4511DY-T1-GE3 Electronic	SI4511DY-T1-GE3-Komponenten	SI4511DY-T1-GE3-Verteiler	SI4511DY-T1-GE3-Bild	SI4511DY-T1-GE3-Teil
SI4511DY-T1-GE3 Preis	SI4511DY-T1-GE3 Hersteller	SI4511DY-T1-GE3 Bild	SI4511DY-T1-GE3 Aktie	SI4511DY-T1-GE3 Inventar
SI4511DY-T1-GE3 Neu	SI4511DY-T1-GE3 Original	SI4511DY-T1-GE3 garantiert	SI4511DY-T1-GE3 RFQ	SI4511DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited